

**Dk 3.31 Df 0.0023 @14GHz**

**Tg (DSC) 200°C**

**T288(銅付) >120分**

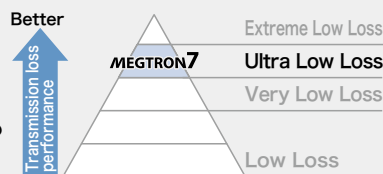
**用途**  
**ネットワーク/ワイヤレス通信**  
 ICTインフラ機器(スーパーコンピュータ、計測用機器)、アンテナ(基地局、車載ミリ波レーダ)、高周波用途 など

## MEGTRON7

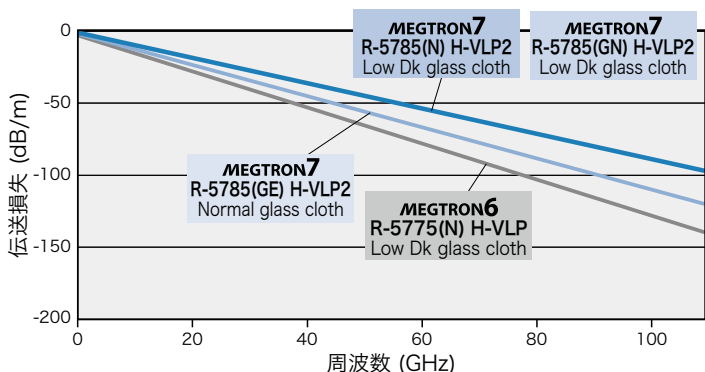
Laminate  
**R-5785(N)\* R-5785(GN)\* R-5785(GE)**  
 Prepreg  
**R-5680(N)\* R-5680(GN)\* R-5680(GE)**  
 \*Low Dk glass cloth type

### 超低伝送損失・高耐熱多層基板材料

業界最高クラスの低誘電率・低誘電正接により大容量・高速伝送に対応し、大型高速サーバの性能向上に貢献。超高多層化・基板サイズの大型化にも対応



### 伝送損失比較



### 高多層耐熱性

#### 評価結果

	φ0.3mm		
	0.4mm	0.5mm	0.6mm
R-5785(N) Low Dk glass cloth/H-VLP2	pass	pass	pass
R-5785(GN) Low Dk glass cloth/H-VLP2	pass	pass	pass

#### 評価条件

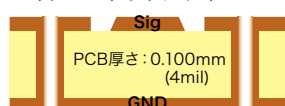
260°Cリフロー×20回

#### 構成

32層  
板厚: 4.5mm

### 構成

マイクロストリップライン



試験方法	2ポート Sパラメータ
試験周波数	10MHz-110GHz
校正方法	TRL法
インピーダンス	50Ω(Zo)

層1: シグナルライン (ライン幅: 270μm、銅箔厚さ: 24μm)

層2: グランドプレーン (銅箔厚さ: 24μm)



R-5785(N)



R-5785(GN)

### 一般特性

項目	試験方法	条件	単位	MEGTRON7 R-5785(N)	MEGTRON7 R-5785(GN)	MEGTRON7 R-5785(GE)	
				Low Dk glass cloth	Low Dk glass cloth	Normal glass cloth	
ガラス転移温度(Tg)	DSC	A	°C	200	200	200	
熱膨張係数 (厚さ方向)	α1	IPC-TM-650 2.4.24	A	ppm/°C	42	42	
					α2	280	280
T288(銅付)	IPC-TM-650 2.4.24.1	A	分	>120	>120	>120	
比誘電率(Dk)	13, 14GHz	平衡型円板共振器法	C-24/23/50	-	3.31 [14GHz]	3.31 [14GHz]	3.60 [13GHz]
誘電正接(Df)					0.0023 [14GHz]	0.0023 [14GHz]	0.0034 [13GHz]
銅箔引き剥がし強さ*	1oz(35μm)	IPC-TM-650 2.4.8	A	kN/m	0.8	0.8	0.8

試験片の厚さは0.75mmです。

※ R-5785(GN), R-5785(GE): H-VLP2, R-5785(N): H-VLP Copper

商品のご採用にあたっては、当社webサイトより注意事項をご確認ください。

上記データは当社測定による代表値であり、保証値ではありません。